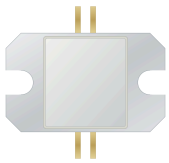
2700–3500 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT 45.5 dBm (typisch)

LCI-PA-2700-3500-PS45p5T-C · 2700–3500 MHz · GaN Gehäuster Leistungsverstärker.



Kennwerte der RF-Tabelle: PSAT 45.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 26.5 dB (typisch); PAE 55 % (typisch). RF-Prüfbedingungen: Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; D = 10%; Pin = 19 dBm.

QF92-4AC

Zuerst Gate-, dann Drain-Vorspannung anlegen. Zuerst Drain-, dann Gate-Vorspannung entfernen.

Vg: C = 10 µF

Vg: 1

RFin: 2

Vd: 3

RFout: 4

Gehäuseabmessungen: 21 × 13 × 4.55 mm.

RF-Kennwerte

Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; D = 10%; Pin = 19 dBm

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Betriebsfrequenz	f	2700	-	3500	MHz
Sättigungsausgangsleistung	-	44.5	45.5	-	dBm
Leistungsverstärkung	-	25.5	26.5	-	dB
Leistungsaddierte Effizienz	-	50	55	-	%
Welligkeit der Leistungsverstärkung	-	-	-	1.5	dB

DC-Bias und Strom

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Wert	Einheit
Drainspannung	-	-	-	-	28	V
Gatespannung	-	-	-	-	-2.8	V

Grenzwerte

Grenzwerte; keine Sollwerte für den Normalbetrieb.

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Maximale Drain-Source-Spannung	-	-	-	32	V
Minimale Gate-Vorspannung	-	-5	-	-	V

Grenzwerte

Grenzwerte; keine Sollwerte für den Normalbetrieb.

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Lagertemperatur	-	-65	-	150	°C
Maximale Eingangsleistung	-	-	-	23	dBm
Maximale Kanaltemperatur	-	-	-	200	°C

Gehäuseabmessungen

Parameter	Wert	Einheit
Gehäuseabmessungen	21 × 13 × 4.55	mm

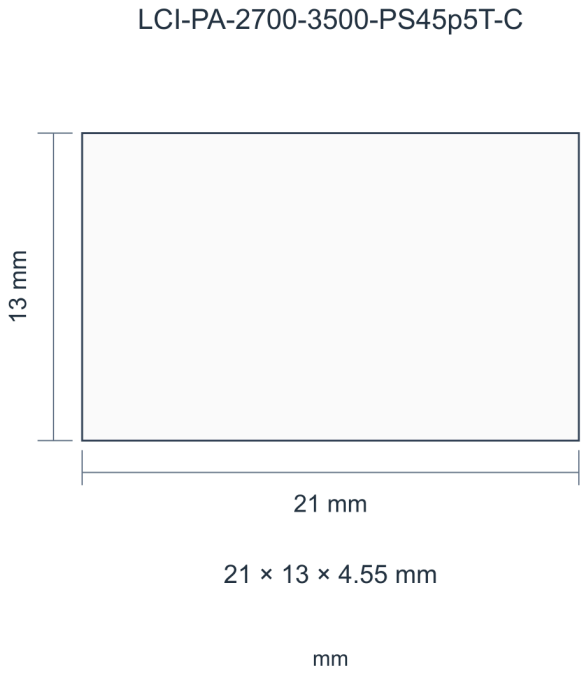
Aktueller Publikationsstand · 1.6 · 2026-11-12. Produktbeschreibung oder redaktionelle Inhalte wurden aktualisiert. Ersetzt Revision 1.5.

Integrationshinweise

QF92-4AC Zuerst Gate-, dann Drain-Vorspannung anlegen. Zuerst Drain-, dann Gate-Vorspannung entfernen. Vg: C = 10 µF Vg: 1 RFin: 2 Vd: 3 RFout: 4

Mechanische Maßzeichnung

Teilzeichnung mit bestätigten Abmessungen in mm. Für die Montage ist der vollständige Montageplan erforderlich.

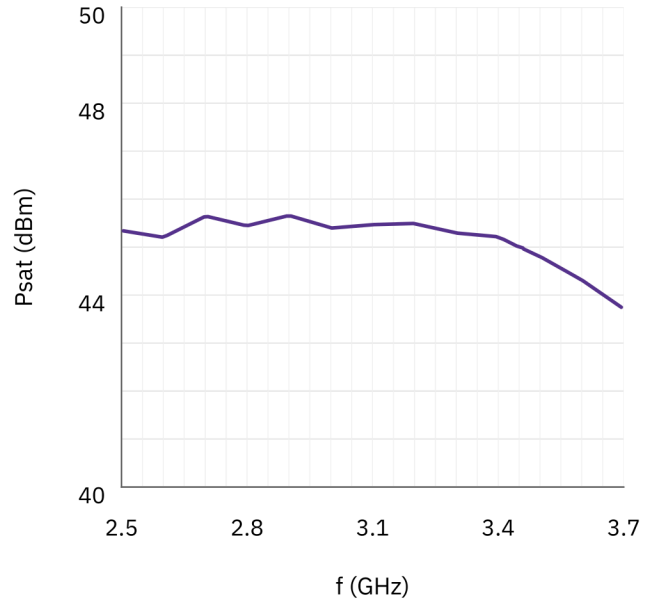


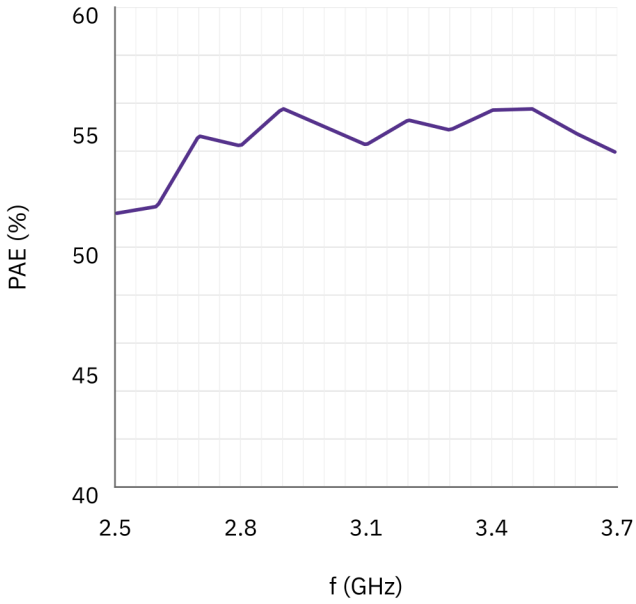
Kennlinien

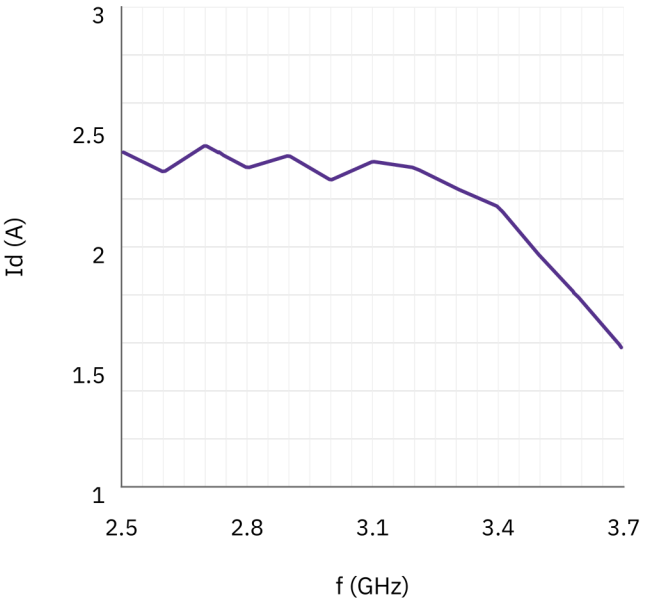
Für jedes Diagramm gelten die jeweils angegebenen Betriebsbedingungen.

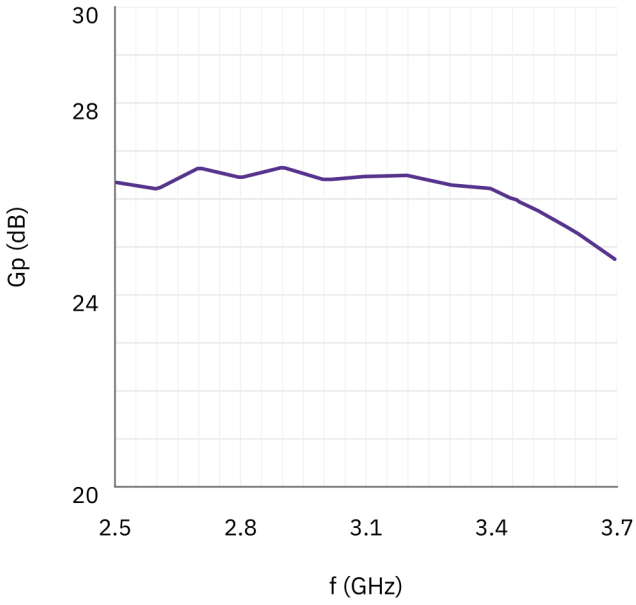
Sättigungsausgangsleistung; Leistungsaddierte Effizienz; Dynamischer Drainstrom; Leistungsverstärkung.

Hinweise zur Abbildung: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.8V; Pin=19dBm. Die ablesbaren Werte sind Näherungswerte. D = 10%.



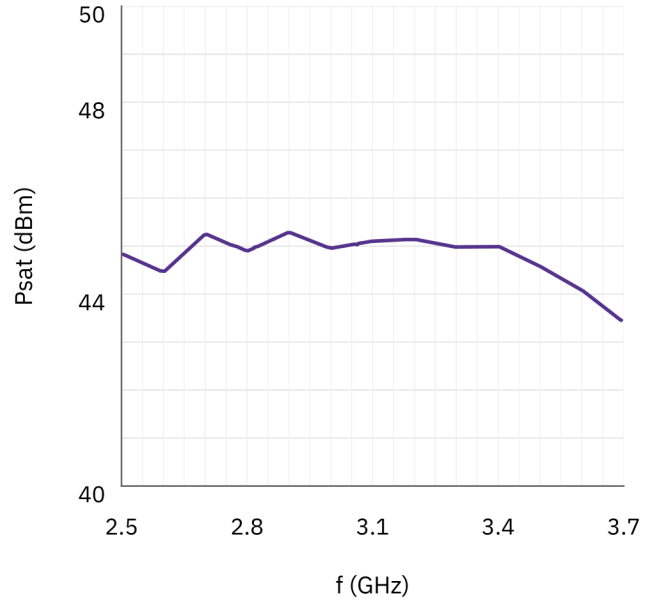


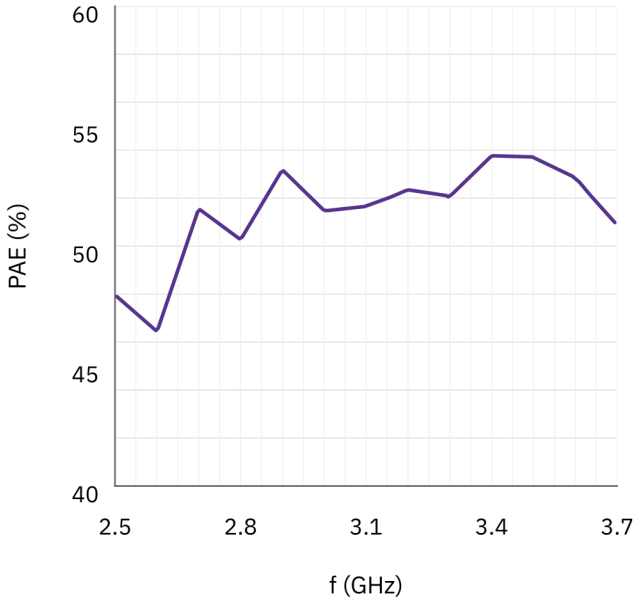


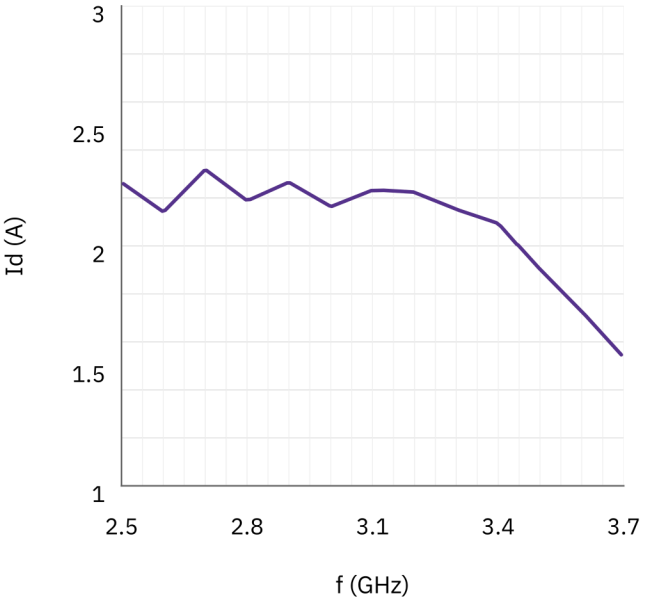


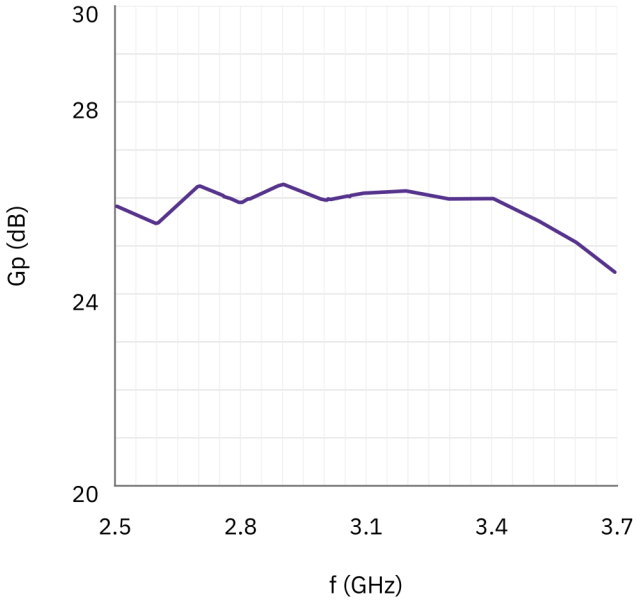
Dauerstrich (CW) — Sättigungsausgangsleistung; Leistungsaddierte Effizienz; Dynamischer Drainstrom; Leistungsverstärkung.

Hinweise zur Abbildung: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.8V; Pin=19dBm. Die ablesbaren Werte sind Näherungswerte.









Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.